

⑫ 公開特許公報(A) 昭63-27829

| ⑬ Int. Cl. | 識別記号 | 庁内整理番号 | ⑭ 公開 昭和63年(1988)2月5日 |
|-------------|-------|-----------|-----------------------|
| G 03 C 1/00 | 3 0 3 | 7267-2H | |
| G 03 F 1/72 | 3 5 3 | 8205-2H | |
| G 03 F 9/00 | | B-7124-2H | 審査請求 未請求 発明の枚 3 (全9頁) |

⑮ 発明の名称 レジスト組成物およびその使用

⑯ 特 願 昭62-145454

⑰ 出 願 昭62(1987)6月12日

優先権主張 ⑱ 1986年6月13日 ⑲ 米国(U S) ⑳ 673914

| | | |
|---------|--------------------|--|
| ⑳ 発 明 者 | ジェームズ・ビンセント・クリベロ | アメリカ合衆国、ニューヨーク州、クリフトン・パーク、カールトン・ロード、756番 |
| ㉑ 発 明 者 | マイケル・ジョセフ・オブライエン | アメリカ合衆国、ニューヨーク州、アルバニイ、ジョリアン・ナンバー3、ジョンストン・ロード、40番 |
| ㉒ 発 明 者 | ジュニア・ラム・リー | アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネクタディ、リバー・ロード、2456番 |
| ㉓ 出 願 人 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ | アメリカ合衆国、12305、ニューヨーク州、スケネクタディ、リバー・ロード、1番 |
| ㉔ 代 理 人 | 弁理士 生沼 徳二 | |

明 細 書

1. 発明の名称

レジスト組成物およびその使用

2. 特許請求の範囲

(1) (A) 有機溶媒 100重量部、ならびに、

(B) (i) 平均分子量が200~20,000であり水または水性塩基に可溶性

の有機ポリマー 100重量部、

(ii) 水または水性塩基に不溶性で沸点が少なくとも100℃の、(1)用の溶解禁止剤である、酸に不安定な基で置換された単純な化合物 5~100重量部、および

(iii) 有効量のアリアルオニウム塩

からなる固形分 5~85重量部

からなるレジスト組成物。

(2) 有機ポリマーがノボラック樹脂であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピンまたは溶液注型可能な組成物。

(3) 酸に対して不安定な基で置換された溶解禁止剤が単純な化合物の第三級ブチルニステルであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピンまたは溶液注型可能な組成物。

(4) アリアルオニウム塩がスルホニウム塩であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピンまたは溶液注型可能な組成物。

(5) アリアルオニウム塩がヨードニウム塩であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピンまたは溶液注型可能な組成物。

(6) 光増感剤を含有することを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピンまたは溶液注型可能な組成物。

(7) 溶解禁止剤がアリアル・p-ブチルニステルであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピンまたは溶液注型可能な組成物。

(8) 溶解禁止剤がアリアル・p-ブチルカーボネートであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピンまたは溶液注型可能な組成物。

(9) オニウム塩がヘキサフルオロアンチモン

該トリフェニルスルホニウムであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピニンまたは溶液注型可能な組成物。

(10) オニウム塩がヘキサフルオロリン酸トリフェニル-4-メトキシフェニルスルホニウムであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピニンまたは溶液注型可能な組成物。

(11) オニウム塩がヘキサフルオロリン酸4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピニンまたは溶液注型可能な組成物。

(12) オニウム塩がトリフルオロメタンスルホン酸4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のスピニンまたは溶液注型可能な組成物。

(13) パターン化されたレジスト基板複合体の製造方法であって、

(i) 基板をレジスト組成物で処理してレジスト-基板複合体を作成し、

(ii) レジスト-基板複合体を約35℃〜180℃

での範囲の温度にベーキングし、

(iii) 適用されたレジストをパターン化された様式で照射し、

(iv) 照射されたレジストを約35℃〜185℃での範囲の温度に加熱し、

(v) 照射されたレジストを現像してパターン化されたレジスト基板複合体を生成せしめる、

ことからなっており、

レジスト組成物が下記の成分からなる方法：

(A) 有機溶媒100重量部、ならびに、

(B) (a) 平均分子量が200〜20,000であり水または水性塩基に可溶性の有機ポリマー100重量部、

(b) 水または水性塩基に不溶性で沸点が少なくとも100℃の、(a)用の溶解禁止剤である、酸に不安定な基で置換された単純な化合物5〜100重量部、および

(c) 有効量のアリアルオニウム塩からなる固形分5〜85重量部。

(14) 特許請求の範囲第13項に記載の方法

によって製造された、基板とレジスト組成物からなる複合体。

(15) 基板がシリコンウェハであることを特徴とする特許請求の範囲第14項に記載の複合体。

(16) 基板が周-クラッド基板であることとを特徴とする特許請求の範囲第14項に記載の複合体。

3. 発明の詳細な説明

発明の概要

本発明以前には、トンプソン(Thompson)らによって1983年アメリカ化学会(American Chemical Society)、ACS第219シンポジウム(ACS Symposium Series 219)、第111頁、「マイクロソグラフィ入門(Introduction to Microlithography)」に示されているように、溶解禁止に基づくノボラックをベースとするポジ型レジストは一般に、純粋な水性塩基による現像に対してノボラック樹脂を不溶性にするための溶解禁止剤として塩化1,2-ジアゾナフトキノン塩を利用していた。これらジアゾナフトキノン塩は照射の依

に軽微を受け、レジストの露光した部分は純粋な水性塩基に対して可溶性になる。これらのポジレジストは広く使われているが通常はジアゾナフトキノンに特有の吸収に基づく365nmより長い近紫外(UV)に限定されている。

イトー(Ito)らの米国特許第4,491,828号に教示されているように、光開始剤としてジアリアルヨードニウム塩類またはトリアリアルスルホニウム塩類を用いるとその結果として近UV領域(200〜300nm)で使用する事ができるポジおよびネガ型で作動するレジスト組成物が得られる。これらの光開始剤は不安定な懸垂(ペンダント)基が接近して存在するビニル系ポリマーと共に使われる。これらのビニル系ポリマーは酸分解を受けてこれら前駆体と溶解性が非常に異なる生成物を生成する。

イトー(Ito)らのレジスト組成物を用いると有効な結果が達成されうが、これらのビニル系ポリマーおよびそれらの酸に不安定な置換されたモノマー性前駆体は市販されていない。さらに、ア

リアルオニウム塩を使用している結果正常な操作条件下で露光した際過剰に酸が生成するため、得られたホトレジストの性能が損われることがある。時には、ホトレジスト組成物中に安定剤を混入することによって、改良された結果が得られることがある。

本発明の基礎となった本発明者の発見は、市販のポリマーをベースの原料として用いて、電子ビーム、X線および5000〜2000nmの範囲のUVに対して感受性のホトレジスト組成物が製造できるということである。このホトレジストは、以下に定義する化学的に結合した酸に不安定な基を有する溶解禁止剤およびリアルオニウム塩と組合せて市販のポリマーを使用することによって、不溶性から可溶性の状態に変換することができる。ホトレジスト溶解機構は完全には理解されていないが、照射されたリアルオニウム塩から酸が発生する際に化学的増幅効果が達成されると考えられる。溶解禁止剤の可溶性状態への変換は酸に不安定な基の遊離によって達成され、これにより、

抽出されたホトレジスト領域が可溶化される。

発明の要旨

本発明によって、水または水性塩基（塩基性水溶液）に可溶なレジストを得るのに有用なレジスト組成物が提供される。この組成物は、重量で、次の割合の成分からなる。

(A) 有機溶媒 100部、ならびに、

(B) 重量で、

(1) 平均分子量(MW)が200〜20,000であり、水または水性塩基に可溶性の有機ポリマー 100部、

(2) 水または水性塩基に不溶性でありかつ沸点が少なくとも100度であり、(1)用の溶解禁止剤である、酸に対して不安定な基で置換された単環系化合物 5〜100部、および

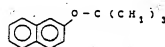
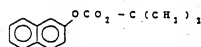
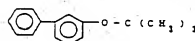
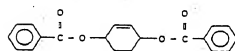
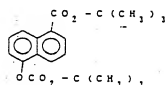
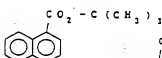
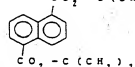
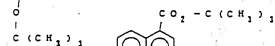
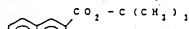
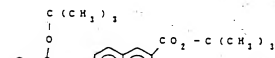
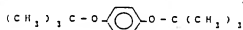
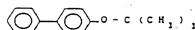
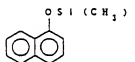
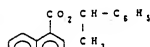
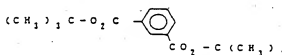
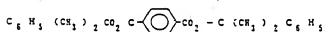
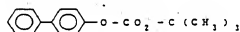
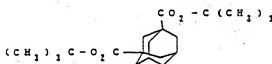
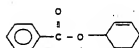
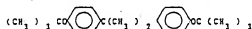
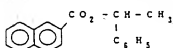
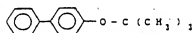
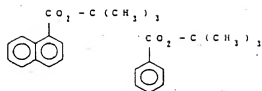
(3) 有効量のリアルオニウム塩からなる固形分 5〜85部。

本発明の実施に際し上記の所望のレジスト組成物を製造するのに利用することができる水または

水性塩基に可溶性の有機ポリマー（以後単に「ポリマー」という）のいくつかとしては、たとえば、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、クロロフェノールノボラック樹脂、メラミンホルムアルデヒド樹脂、水性性デンブ、セルロースポリマー（たとえば、カルボキシメチルヒドロキシニチルセルロース、プロポキシ化セルロース）、ポリアクリルアミド、ポリ-2-ヒドロキシニチルメタクリレート、ポリメチルビニルエーテル、ポリニチレンオキシド、4-ヒドロキシフェニルマレイミドと、スチレン、スチルベン、ビニルエーテル類および1-ヒドロキシニチレンの中から選択されたものとのコポリマー、ならびにポリ-4-ビニルフェノール、ポリ-4-ヒドロキシ-6-メチルスチレン、ポリアクリルアクリル酸およびポリメタクリル酸のようなポリマーがある。

本発明を実施する際に、水または水性塩基可溶性レジストを製造するのに使用することができる酸不安定な基で置換した単環系化合物、すなわち

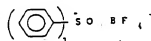
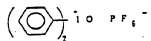
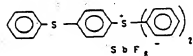
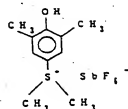
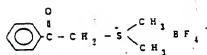
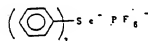
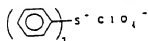
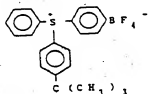
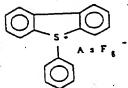
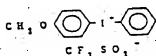
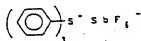
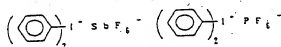
溶解禁止剤（以後単に「禁止剤」という）の中には、たとえばつぎに挙げるものがある。

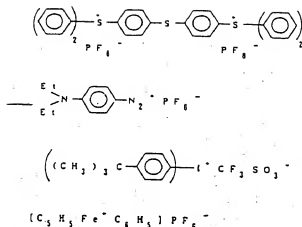


本発明の禁止剤は分子量が約1000未満のものが好ましい。それらは該に対して不安定な無重基をもち、その無重基はカルボン酸の *tert*-ブチルエステルおよびフェノール類の *tert*-ブチルカーボネートが好ましい。さらにこれらの酸に不安定な基はトリチル、ベンジル、ペンシドリルおよび上記の禁止剤中に例示した無重基であってもよい。たとえば、トリアリールスルホニウム塩、ジアリールクロロニウム塩、ジアリールプロモニウム塩、トリアリールセレニウム塩、チオビリリウム塩、キサンチリウム塩、イミダゾリウム塩、ジアルキルフェナシルスルホニウム塩、ジアルキルヒドロキシフェニルスルホニウム塩、フェロセニウム塩、ジアソニウム塩、トリアリールスルホオキシニウム塩、ジアリールオキシニウム塩、フェナシルトリアリールホスホニウム塩、フェナシルトリアルキルアンモニウム塩、フェナシルビリジニウム塩がある。その他の例はチンベ(H.-J. Tlape) およびバウマン(Bausmann)によって提議(Adhesion), 9, 9 (1

984) に、またクリベロ(Crivello)によって米特許第4,058,440号、第4,058,401号、第4,059,055号および第4,151,175号(これらは本発明と同じ題号人に譲渡されており、引用によって本明細書中に含まれるものとする)に挙げられている。

次に別のオニウム塩のいくつかの例を挙げる。





レングリコール、プロピレングリコール、酢酸アミルおよび酢酸ブチルがある。

さらに本発明は、基板上にパターン化されたレジストを製造する方法を提供する。この方法は、

(1) 基板を本発明のレジスト組成物で処理、すなわちスピン塗布、噴霧、溶液注型、または浸漬塗布してレジスト-基板複合体を作成し、

(2) このレジスト-基板複合体を約35度〜180度の範囲の温度にベーキングし、

(3) 適用（塗布）されたレジストをパターン化された様式で照射し、

(4) 照射されたレジストを約35度〜185度の範囲の温度に加熱し、

(5) 照射されたレジストを現像してパターン化されたレジスト-基板複合体を生成せしめることからなる。

レジスト-基板複合体を製造するために本発明の方法を実施する際に処理することができる基板の中には阴-クラッド（炭素）膜層、シリコン（ケイ素）ウェハ、二酸化ケイ素ウェハ、アルミ

本発明の組成物は、有機溶媒、ポリマー、禁止剤、および照射によって分解しうる開始剤をブレンドすることによって製造することができる。

このレジスト組成物を製造する際、各成分の添加順序は特に重要ではない。ポリマー100部につき禁止剤を約5〜約100部、開始剤を約0.5〜約25部用いると有効な結果が得られることが判明している。好ましい場合として、ポリマー100部に対して開始剤を5〜10部、かつポリマー100部に対して開始剤を1〜20部使用することができる。

ここで有機溶媒という用語には、本発明を実施する際にレジスト組成物の製造に使用することができる有機溶媒またはそのような有機溶媒の混合物が含まれ、たとえば1, 2-ジメトキシエタン、ジ(2-メトキシエチル)エーテル、酢酸1-メトキシ-2-プロピル、クロロベンゼン、1, 1, 2, 2-テトラクロロエタン、酢酸1-メトキシ-2-エチル、ジオキサン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、n-ブタノール、ニチ

ニウムおよびヒガリウムがある。

本発明の方法を実施する際に用いることができる現像剤の例としては塩基性溶液、たとえばNaOH、KOHおよび水溶性テトラブチルアンモニウムの水溶液がある。典型的な現像液は、米国メイン州(Maine)、ニュートン社(Newton)製のシャプレー(Shopley)、米国ロードアイランド州(Rhode Island)、イースト・プロビデンス社(East Providence)製のフント(Hunt)、および米国コネチカット州(Connecticut)、ワリングフォード社(Wallingford)製のKTIである。

さらに、上記のオニウム塩すなわち開始剤は、所定の波長の光の吸収をよくするため、またはオニウム塩を吸収のないスペクトル領域に増強するため、各種の光増感剤と組合せて使用することができるということが見出されている。上記の開始剤またはそれらの混合物と組合せて用いることができる典型的な増感剤としては、たとえばベンゾフェノン、2-クロロチオキサントジン、アントロン、9-メトキシアントラセン、アントラセン、

ビレン、ベリレン、フェノチアジン、ベンジル、アクリジンオレンジ、ベンゾフラビン、セトフラビン-T、アントラキノン、9, 10-ジフェニルアントラセン、9-フルオロネン、ベンゾフェノン、およびコロネンがある。

また、上記の増感剤を本発明の実施の際に用いられる開始剤と組合せて使用して電子ビームおよびX線照射下ならびに可視光またはUVの照射下でのホトレジストの成膜を促進することとできる。

本発明のレジスト組成物の考えられる応用例のいくつかとしては、たとえば回路板、集積回路、たとえばポリメチルメタクリレートと組合せた多層レジスト誘導体などがある。本発明のレジスト組成物中には、流動潤滑剤、表面活性剤、反射防止染料および増感剤を用いることもできる。

当業者がより容易に本発明を実施できるように以下に実施例を例示して説明する。しかし本発明はこれらの実施例に限定されることはない。部とあるのはすべて重量部である。

| フェノール樹脂 | 増感剤/水 |
|--------------|------------|
| メタクレゾールノボラック | 1 : 1 |
| ポリビニルフェノール | 5 : 1 (浸漬) |
| エーブチルフェノール | |
| ノボラック | 5 : 1 (浸漬) |

これらのレジストを現像したところ、2~3、5 μmの像が解像できた。

実施例2

以下のようにして禁止剤のエーブチルナフタレン-2-カルボキシレートとを製造した。

2-ナフトニ酸51.6g(0.3モル)とチオニクロライド120mlの混合物を1時間還流した。過剰のチオニクロライドを除去した。得られた固体をテトラヒドロフラン150mLに溶かし、カリウムエーブチンシド40g(0.35モル)を増量しながら加えた。この添加が完了した後反応混合物を4時間還流し、冷却し、次いで水中に注いだ。得られた固体を通過して洗め、水

実施例1

市販の各種フェノール樹脂(分子重約1,000)1.5g、ジ-エーブチルテレフタレート0.5g、ジフェニル-4-チオフェノキシフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート0.1g、および1-メトキシ-2-プロピルアセテート5mLを使用してホトレジスト組成物を製造した。これら各種のホトレジスト組成物を、予めヘキサメチルジシランで処理しておいたシリコンウェハの上にスピンコートした。処理したウェハを90℃で1/2時間ベーキングした。次にこれらのウェハを露光して像を形成する照射は、サス(Suss)MA56接触/近接プリンターを313nmの近接モードで動作させ、露出時間は10~40秒、強度は4.5mW/cm²として行なった。露光後ウェハを強制逆気オープン中で60秒間110~130℃に加熱し、次に水とKTI351増感剤の混合物を用いて現像した。使用した市販の「フェノール樹脂」と、現像液混合物および現像法を次に示す。

で洗い、減圧下で乾燥した。この生成物をn-ヘキサンで再結晶すると融点が88~90℃の結晶性の固体が得られた。この製造による生成物はエーブチルナフタレン-2-カルボキシレートであり、これは88%の収率で得られた。

実施例1の手順に従い、メタクレゾールノボラック樹脂1.5g、エーブチルナフタレン-2-カルボキシレート0.5g、ジフェニル-4-チオフェノキシフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート0.1g、および1-メトキシ-2-プロピルアセテート5mLを使用してホトレジスト組成物を製造した。実施例1の手順に従って作成した被置シリコンウェハを、照射時間を15~40秒として像が形成するようにUV光で露光すると、解像度が3.5μmと良好な、優れたポジ型の像が得られた。

実施例3

市販のメタクレゾールノボラック樹脂をジ-エーブチルテレフタレートまたはエーブチルナフ

タレン-2-カルボキシレートと共に用いて別のホトレジスト組成物を製造した。ジ- ϵ -ブチルテフタレート溶解禁止剤を用いてホトレジストを製造する際には、メタ-クレゾールノボラック樹脂1.5g、禁止剤0.5g、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムトリフルオロメチルスルホネート0.1g、および光増感剤として9-フルオレノン0.03gを使用した。

ϵ -ブチルナフタレン-2-カルボキシレートを用いたホトレジストを、メタ-クレゾールノボラック樹脂1.5g、禁止剤0.5g、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムトリフルオロメチルスルホネート0.1g、光増感剤としてのペリレン0.01g、および1-メトキシ-2-プロピルアセテート6mLと組合せた。

上記のホトレジスト組成物を実施例1の手順に従ってシリコンウェハ上にスピンコートした。ジ- ϵ -ブチルテフタレート禁止剤と9-フルオレノン光増感剤を含むホトレジスト組成物は3.13nmで5秒間照射し、 ϵ -ブチルナフタレ

ン-2-カルボキシレートとペリレンに感測を含むホトレジスト組成物は3.65nm(6.3mW/cm²)および4.05~4.36nm(8.1mW/cm²)で5秒間照射した。使用した禁止剤、光増感剤および波長の組合せを次の表に示す。

| 禁 止 剤 | 光増感剤 | UV λ (nm) |
|---|----------|-------------------|
| ジ- ϵ -ブチル テフタレート | 9-フルオレノン | 313 |
| ϵ -ブチルナフタレ ン-2-カルボキシ レート | ペリレン | 405-436 365 |

上記の条件下KTI350現像液中でレジストを加工処理した。1 μ mの像が解像できた。

実施例4

禁止剤の ϵ -ブチル-2-ナフチルカーボネートを次の手順によって製造した。

2-ナフトール5g(0.35モル)をテトラヒドロフラン90mLに溶かした溶液に、窒素雰

囲気下でカリウム ϵ -ブチリド3.9g(0.035モル)を加えた。この混合物を5分間攪拌し、ジ- ϵ -ブチルジカーボネート8.3g(0.035モル)を加えた。混合物を2時間攪拌した。次にこの混合物を水中に注ぎ、エチルアセテートで3回抽出した。一併にした有機液を水で3回、次に飽和食塩水で洗浄した後無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。次いで混合物をロータリーエバポレーターで濃縮した。結晶性の固体が得られ、これを石油エーテルで再結晶した後圧下で乾燥した。融点が74~75度の ϵ -ブチルナフチルカーボネートが収率65%で得られた。

実施例1の手順に従い、市販のメタ-クレゾールノボラック樹脂1.2g、 ϵ -ブチル-2-ナフチルカーボネート0.8g、ジフェニル-4-チオフェノキシフェニルフェニルヨードニウムヘキサフルオロボスフェート0.1gおよび1-メトキシ-2-プロピルアセテート6mLを用いてホトレジスト組成物を製造した。ウェハにスピンコートし、実施例1に記述したようにして20~40秒露光

し、125で30~60秒間ベークングした。ホトレジストをKTI351と水の1:2.5混合物中で1分間現像すると、くっきりした2 μ mのライン/スペースが得られた。

実施例5

実施例1の手順に従い、m-クレゾールノボラック樹脂1.2g、4- ϵ -ブチル-2-プロピルフェニル0.8g、ジフェニル-4-チオフェノキシフェニルフェニルヨードニウムヘキサフルオロボスフェート0.1gおよび1-メトキシ-2-プロピルアセテート6mLを用いてホトレジスト組成物を製造した。波長したウェハを3.13nmのUVに20~40秒間露光し、125で30~60秒間ベークングし、KTI351と水の1:1混合物に浸漬して、くっきりと解像された3 μ mのライン/スペースを得た。

実施例6

市販のメタ-クレゾールノボラック樹脂1.5

g、 ϵ -ブチル-1-H-インデン-3-カルボキシレート500mg、ジフェニル-4-チオフェノキシフェニルホルムニウムヘキサフルオロホスフェート100mg、および1-メトキシ-2-プロピルアセテート5mlを用いてホトレジスト組成物を製造した。このホトレジストを実施例1に記載したようにしてスピンコートし照射した。313nmで15~20秒間照射し、125℃で30~60秒間ベーキングし、KTI351現像剤と水の1:1溶液中で1分間現像して、くっきりした2.5 μ mのライン/スペースを得た。

実施例7

市販のメタクレゾールノボラック、 ϵ -ブチルアブマクタン-1-カルボキシレート、各種の開始剤、および1-メトキシ-2-プロピルアセテートを用いてホトレジスト組成物を製造した。これらのホトレジスト組成物のうちのあるものは、メタクレゾールノボラック1.5g、 ϵ -ブチルアブマクタン-1-カルボキシレート500mg、

RJ2606]1.5g、ジ ϵ -ブチルアジベート500mg、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート100mg、および1-メトキシ-2-プロピルアセテート5mlで構成されたホトレジスト組成物を、予めヘキサメチルジシランで処理しておいたシリコンウェハにスピンコートし、ベーキングした。膜厚が2 μ mの膜を得た。このホトレジスト組成物を、サス(Suss)MA56接触/近接プリンターを254nm近接モードで動作させて露光し、5.22mW/cm²として4~5秒間露光した。露光後ウェハを130℃で30~60秒間ポストベーキングし、次いでKTI351と水の1:1混合物中で60秒間現像した。解像度のよい彫像パターンが3.5 μ mのライン/スペースで得られた。

実施例9

実施例8のm-クレゾールノボラック樹脂3gをメチルエチルケトン10mlに溶解した。得られた溶液に、 ϵ -ブチル-2-ナフタレンカルボ

ジフェニル-4-チオフェノキシフェニルホルムニウムヘキサフルオロホスフェート100mg、および1-メトキシ-2-プロピルアセテート5mlを共にブレンドして作成した。別のホトレジストの混合では、メタクレゾールノボラック樹脂を1.5g、禁止剤を500mg、4-メトキシフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェートを110mgおよび1-メトキシ-2-プロピルアセテートを5ml使用した。これら各様のホトレジスト組成物をすでに記載したようにしてシリコンウェハに塗布し、5.22mW/cm²の強度で、313nmで10~15秒間、254nmで2~3秒間露光して膜を形成した。このレジストを実施例1の手順に従って加工した。スルホニウム含有ホトレジストでは3 μ m、ヨードニウム含有ホトレジストでは2.5 μ mの解像度が得られた。

実施例8

m-クレゾールノボラック樹脂[シェネクタデー・ケミカルズ(Schenectady Chemicals)型H

キシレート1g、ベリレンを0.02g、および4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネートを0.2gを加えた。この混合物を四クラッドニコネジガラス回路板の上に塗布し、乾燥して溶剤を除去した。乾燥した回路板をマイラー(Mylar)樹脂製の革蓋ネグで覆った。このネグを、800Wで安定させたGEH-3T7中圧水銀灯を用いて8インチの距離から30秒間照射した。像形成の後回路板を100℃で3分間ベーキングし、KTI351と水の1:1混合物中で現像した。次いで塩化第二鉄の水溶液を用いてこのパターンを回路板にエッチングしてマスクのくっきりしたポジ型を得た。

上記の結果は本発明の実施の際に使用することができる非常に多くの変形のうちのほんの数例に過ぎるだけであるが、本発明はこれらの実施例のみに記載したずっと広範囲のポリマー、禁止剤および開始剤を使用することができるものである。